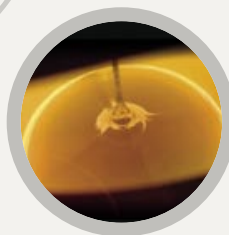


ALTECHNA

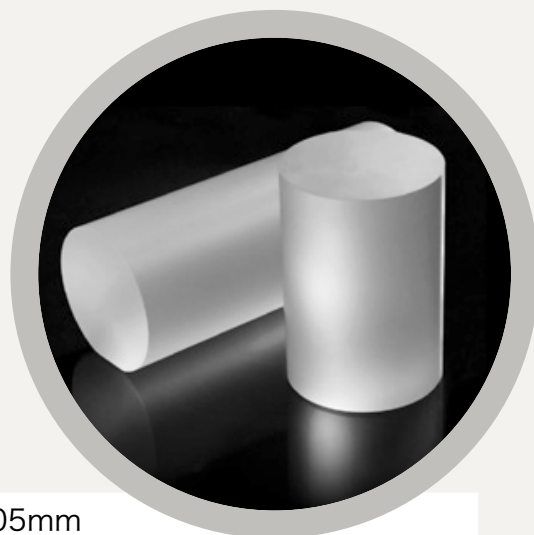


4インチ 単結晶サファイアインゴット

Kyropoulos法

特徴

- 低転位密度
- クラック/ピットなし
- 高性能
- 優れた耐費用効果



4" Sapphire Ingot Specification

径	100.2 + 0.05mm
オリエンテーション	C面: [0001]
	傾斜M軸: 0.0 ± 0.1°
	傾斜A軸: 0.0 ± 0.1°
基本面オリエンテーションA軸	[11-20] ± 0.2°
基本面長	30 + 0.5mm
面粗	1 ± 0.2 μm
欠陥域	< 15%
平均インゴット長	40 mm